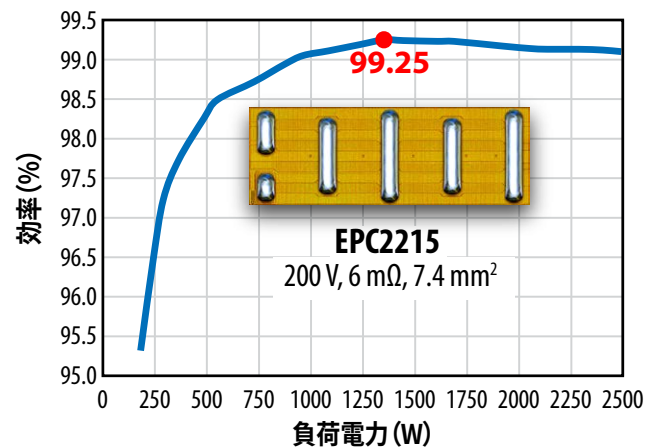
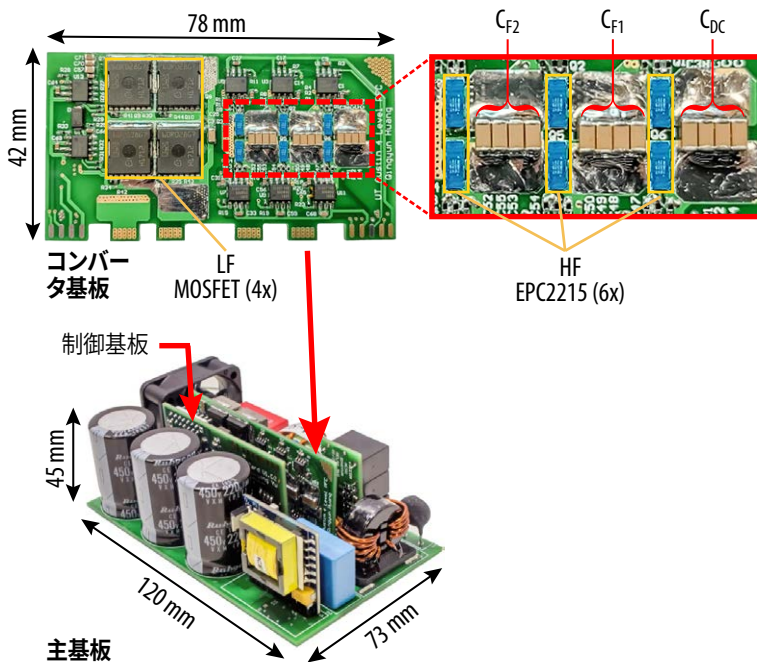


1 kW~3 kWの汎用入力 の力率補正 (PFC) 向け eGaN® FETとIC



なぜPFCにGaNなのですか？

- 高効率 (99%以上)
- 小型
- 低高調波歪み
- 4レベルのフライング・キャパシタ型マルチレベル (FCML) ・トータムポール・ブリッジレスPFC構成は200 VのGaNデバイスを利用



リファレンス・デザイン	V _{IN}	V _{OUT}	電力レベル	搭載製品
汎用入力の4レベル・トータムポールPFC	85 V _{AC} - 264 V _{AC}	400 _{DC}	2.5 kW	EPC2215



型番	構成	V_{DS}	最大 $R_{DS(on)}$ ($m\Omega$) @ $5V_{GS}$	Q_G 標準値 (nC)	Q_{GS} 標準値 (nC)	Q_{GD} 標準値 (nC)	Q_{OSS} 標準値 (nC)	Q_{RR} (nC)	I_D (A)	パルス I_D (A)	パッケージ (mm)	ハーフブリッジ 開発基板
EPC2019	シングル	200	50	1.8	0.6	0.35	18	0	8.5	42	LGA 2.77 x 0.95	EPC9014
EPC2010C	シングル	200	25	3.7	1.3	0.7	40	0	22	90	LGA 3.6 x 1.6	EPC9003C
EPC2207	シングル	200	22	4.5	1.3	0.7	23	0	14	54	LGA 2.9 x 0.9	EPC90124
EPC2215	シングル	200	8	13.6	3.3	2.1	69	0	32	162	LGA 4.6 x 1.6	EPC9099
EPC2034C	シングル	200	8	11.4	3.8	2.1	95	0	48	213	BGA 4.6 x 2.6	EPC9048C

表のデータは変更されることがあります。www.epc.comの製品セクションを参照してください。

設計サポート資料@ www.epc-co.com/epc/jp

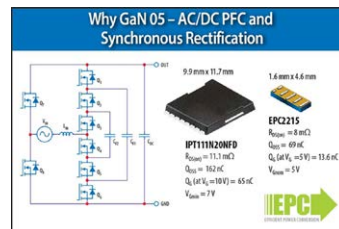


書籍

GaN Transistors for Efficient Power Conversion

ビデオ

AC / DC PFCと同期整流に
なぜGaN



アプリケーション・ノート

200 VのeGaN® FETを使った高効率、2.5 kW、汎用入力電圧範囲、力率補正 (PFC) 付きの400 Vの整流器設計方法



詳細については、
info@epc-co.comに電子メールで、またはお近くの販売代理店にお尋ねください。
EPCのウェブサイト: epc-co.com/epc/jp/
bit.ly/EPCupdates に登録



eGaNは、Efficient Power Conversion Corporation, Inc.の登録商標です